

产品概览

FCPF125N65S3: 功率 MOSFET , N 沟道 , SUPERFET® III , Easy Drive , 650 V , 24 A , 125 mΩ , TO-220F

欲看完整文档, 请参阅数据表。

SUPERFET III MOSFET 是安森美半导体的全新高压超结 (SJ) MOSFET 系列, 利用电荷平衡技术实现出色的低导通电阻, 以及更低门极电荷方面的卓越性能。此先进工艺专用于最大程度降低导电损耗, 提供卓越的开关性能, 并且可以承受极端 dv/dt 速率。因此, SUPERFET III MOSFET Easy drive 系列有助于管理 EMI 问题, 实现更简单的设计实施。

特性

- 700 V @ $T_J = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Ultra Low Gate Charge (Typ. $Q_g = 44\text{ nC}$)
- Low Effective Output Capacitance (Typ. $C_{oss}(\text{eff.}) = 405\text{ pF}$)
- Optimized Capacitance
- Internal Gate Resistance: 4 ohm
- Typ. $R_{DS}(\text{on}) = 105\text{ m}\Omega$
- 100% Avalanche Tested
- RoHS Compliant

应用

- Telecommunication
- Cloud system
- Industrial

优势

- Higher system reliability at low temperature operation
- Lower switching loss
- Lower switching loss
- Lower peak V_{ds} and lower V_{gs} oscillation
- Lower peak V_{ds} and lower V_{gs} oscillation

终端产品

- Telecom power
- Server power
- EV charger
- Solar / UPS

器件电气规格

产品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Channel Polarity	Configuration	$V_{DSS}(\text{Min})$ (V)	$V_{GS}(\text{Max})$ (V)	$V_{GS}(\text{th})$ (V)	$I_D(\text{Max})$ (A)	$P_D(\text{Max})$ (W)	$R_{DS}(\text{on})$ (mΩ) Max @ $V_{GS} = 2.5\text{ V}$	$R_{DS}(\text{on})$ (mΩ) Max @ $V_{GS} = 4.5\text{ V}$	$R_{DS}(\text{on})$ (mΩ) Max @ $V_{GS} = 10\text{ V}$	Q_g (nC) Typ @ $V_{GS} = 4.5\text{ V}$	Q_g (nC) Typ @ $V_{GS} = 10\text{ V}$	C_{iss} (pF) Typ	Package Type
FCPF125N65S3	1.3099	Pb-free Halide free	Active	N-Channel	Single	650	±30	4.5	24	38	-	-	125	-	44	1790	TO-220-3 FullPak

欲了解更多信息, 请联系您当地的销售支援 www.onsemi.cn。

创建于: 4/2/2020